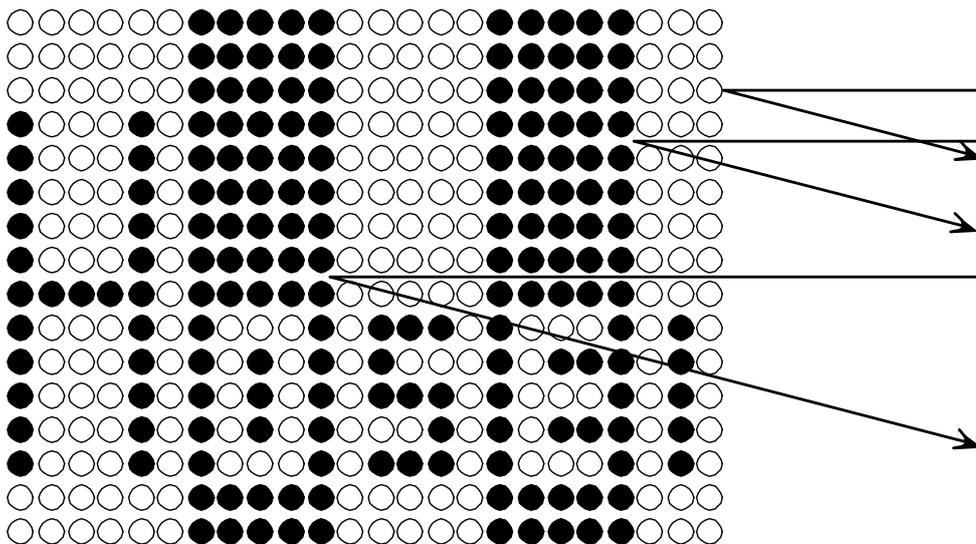


第 30 回法政大学
イオンビーム工学研究所シンポジウム

The 30th Symposium on Materials Science and Engineering
Research Center of Ion Beam Technology
Hosei University

PROGRAM



期日 2011年12月7日(水)
会場 法政大学 小金井キャンパス
西館地下1階マルチメディアホール
主催 法政大学イオンビーム工学研究所

あいさつ

10 : 40~10 : 45

I

10 : 45~12 : 15

招待講演 I

放射線計測の信頼性

(45分)

産業技術総合研究所

工藤 勝久

招待講演 II

化合物半導体を用いた放射線検出器

(45分)

東北大学

人見 啓太郎

昼食

12 : 15~13 : 15

II

13 : 15~14 : 45

招待講演 III

半導体デバイスの放射線耐性強化技術の開発

(45分)

日本原子力研究開発機構

大島 武

招待講演 IV

放射性物質の吸収を低減させる農法の研究

(45分)

法政大学

石井 秀樹

休憩

14 : 45~15 : 00

III ショート講演 (各5分)

15 : 00~15 : 35

1. 高温燃焼グラファイトを用いた X 線管の評価
鬼塚 硝子 ◦岩井 勇輔、小池 高寿、定塚 淳生、羽山 洋平、中村 智宣、鬼塚 好弘
2. SiO₂/Si 膜中へイオン注入された Fe の拡散・反応過程の研究
神奈川大学 ◦横山 愛、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
3. STM, RHEED による Co/Graphite 表面観察
神奈川大学 ◦梶原 覚、古川 明裕、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
4. マイクロ波プラズマ CVD 法によるダイヤモンド薄膜の分析評価
神奈川大学 ◦白井 彰眞、本杉 太郎、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
5. 加速器を利用した原子力人材育成のための実習プログラム
東京大学 ◦伊藤 誠二、松崎 浩之、森田 明
6. イオン・陽電子ビーム同時照射によるその場分析装置の開発
産業技術総合研究所 ◦木野村 淳、鈴木 良一、大平 俊行、大島 永康、
Brian E. O'Rourke、西島 俊二
7. ラザフォード後方散乱分析法(RBS)による固体高分子型燃料電池排出水中の不純物原子分析
東京工業大学、東京都市大学*、東京大学**
◦川崎 克則、服部 俊幸、鳥山 保*、高木 靖雄*、伊藤 誠二**、
森田 明**、実吉 啓二、小栗 慶之

休憩

15 : 35~15 : 50

8. C⁻、Si⁻、Al⁻イオン注入 ZnO バルク単結晶の電気伝導特性：低抵抗化の起源
法政大学、大阪教育大学*、
◦尾賀 孝宏、井澤 佑介、松本 孝治、栗山 一男、串田 一雅*
9. Ge イオン注入 ZnO バルク単結晶からのフォトルミネッセンスおよび電気伝導特性
法政大学、大阪教育大学*
◦上岡 一馬、尾賀 孝宏、井澤 佑介、栗山 一男、串田 一雅*
10. H₂O 導入 MOCVD 成膜 CeO₂ 薄膜の電気特性と構造の温度依存性
法政大学、コメット* ◦多田 直裕、木樽 智也、島田 洋希、岡崎 拓也、
鈴木 撰*、石橋 啓次*、山本 康博
11. 4H-SiC を用いた p-n 接合ダイオード特性のプラズマ処理効果
法政大学 ◦平賀 祐作、杉本 尚丈、田島 卓、西村 智朗、中村 徹
12. 4H-SiC 基板上イオン注入 T 型ゲート GaN HEMT の RF 特性
法政大学 ◦外崎 翔、片寄 秀雄、野本 一貴、中村 徹
13. 自己整合型イオン注入 Mg doped GaN MISFET
法政大学 ◦福田 俊、田口 真也、野本 一貴、中村 徹
14. C-V 測定法による室温 Al 注入 4H-SiC の周波数・温度特性の評価
法政大学 ◦斎藤 友紀雄、西村 智朗、中村 徹
15. プラズマ処理によるイオン注入 SiC の表面荒れ低減のガス比較
法政大学 ◦飯嶋 弘幸、西村 智朗、中村 徹
16. 真空中での熱処理後の 4H-SiC 表面の評価
法政大学 ◦松井 章、西村 智朗、中村 徹
17. 単結晶 SiGe 薄膜の結晶性と電気特性
法政大学、産業技術総合研究所*、Shanghai Inst. Micro. Info. Tech**
◦渡邊 与典、大島 隆治*、坂田 功*、劉 正新**、坂本 勲
18. Fe/Cr 多層膜の電気・磁気特性と熱処理効果
法政大学、産業技術総合研究所*、島根大学**
◦神野 達哉、坂本 勲、小池 正記*、本多 茂男**

